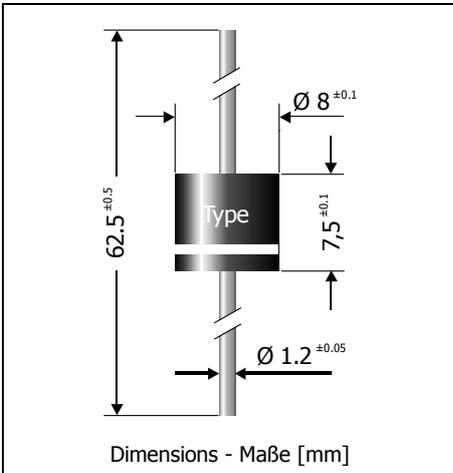


F1200A ... F1200G
Superfast Silicon-Rectifiers
Superschnelle Silizium-Gleichrichter

Version 2007-05-09



| | |
|---|------------------------------|
| Nominal Current Nennstrom | 12 A |
| Repetitive peak reverse voltage Periodische Spitzensperrspannung | 50...400 V |
| Plastic case Kunststoffgehäuse | Ø 8 x 7.5 [mm] P600 Style |
| Weight approx. Gewicht ca. | 1.3 g |
| Plastic material has UL classification 94V-0 Gehäusematerial UL94V-0 klassifiziert | |
| Standard packaging taped in ammo pack Standard Lieferform gegurtet in Ammo-Pack | |



Maximum ratings

Grenzwerte

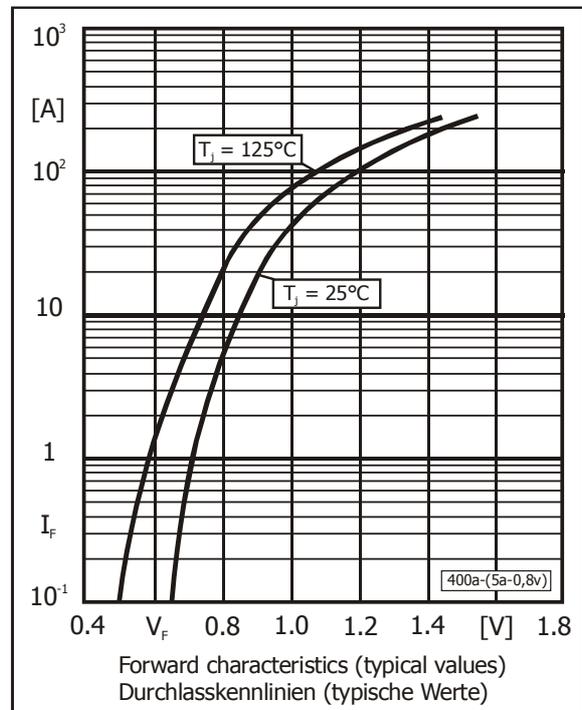
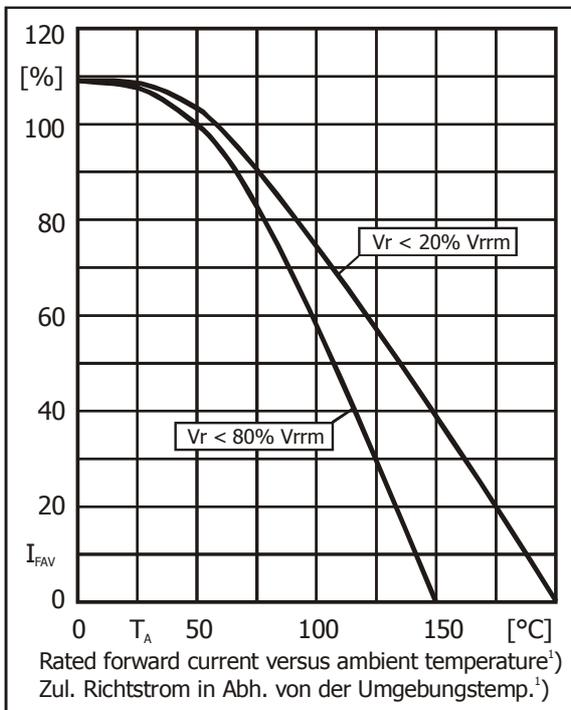
| Type Typ | Repetitive peak reverse voltage Periodische Spitzensperrspannung V_{RRM} [V] | Surge peak reverse voltage Stoßspitzensperrspannung V_{RSM} [V] |
|-------------|--|---|
| F1200A | 50 | 50 |
| F1200B | 100 | 100 |
| F1200D | 200 | 200 |
| F1200G | 400 | 400 |

| | | | |
|--|--------------------------|-----------|----------------------|
| Max. average forward rectified current, R-load Dauergrenzstrom in Einwegschaltung mit R-Last | $T_A = 50^\circ\text{C}$ | I_{FAV} | 12 A ¹⁾ |
| Repetitive peak forward current Periodischer Spitzenstrom | $f > 15\text{ Hz}$ | I_{FRM} | 80 A ¹⁾ |
| Peak forward surge current, 50/60 Hz half sine-wave Stoßstrom für eine 50/60 Hz Sinus-Halbwelle | $T_A = 25^\circ\text{C}$ | I_{FSM} | 375/390 A |
| Rating for fusing, $t < 10\text{ ms}$ Grenzlastintegral, $t < 10\text{ ms}$ | $T_A = 25^\circ\text{C}$ | i^2t | 680 A ² s |
| Junction temperature – Sperrschichttemperatur at reduced reverse voltage bei reduzierter Sperrspannung | $V_R \leq 80\% V_{RRM}$ | T_j | -50...+150°C |
| | $V_R \leq 20\% V_{RRM}$ | T_j | -50...+200°C |
| Storage temperature – Lagerungstemperatur | | T_S | -50...+175°C |

¹ Valid, if leads are kept at ambient temperature at a distance of 10 mm from case
 Gültig, wenn die Anschlussdrähte in 10 mm Abstand vom Gehäuse auf Umgebungstemperatur gehalten werden

Characteristics
Kennwerte

| | | | |
|---|--|-----------|----------------------|
| Forward Voltage – Durchlass-Spannung | $T_j = 25^\circ\text{C}$ $I_F = 5\text{ A}$ | V_F | $< 0.82\text{ V}$ |
| Leakage current – Sperrstrom | $T_j = 25^\circ\text{C}$ $V_R = V_{RRM}$ | I_R | $< 25\ \mu\text{A}$ |
| Reverse recovery time Sperrverzögerung | $I_F = 0.5\text{ A}$ through/über $I_R = 1\text{ A}$ to/auf $I_R = 0.25\text{ A}$ | t_{rr} | $< 200\text{ ns}$ |
| Thermal resistance junction to ambient air Wärmewiderstand Sperrschicht – umgebende Luft | | R_{thA} | $< 10\text{ K/W}^1)$ |
| Thermal resistance junction to leads Wärmewiderstand Sperrschicht – Anschlussdraht | | R_{thL} | $< 2\text{ K/W}$ |



¹ Valid, if leads are kept at ambient temperature at a distance of 10 mm from case
 Gültig, wenn die Anschlussdrähte in 10 mm Abstand vom Gehäuse auf Umgebungstemperatur gehalten werden